3.9 An npn bipolar junction transistor (npn BJT) is a three-terminal device that, for biasing purposes, can be modeled with two elements as shown in Figure P3.9. One element draws current I_B at voltage V_{BE} , and the other draws current I_C at voltage V_{CE} . Using a 12-V voltage source and three suitable resistances, design a circuit to bias a BJT at $I_B = 10\mu$ A with $V_{BE} = 0.7$ V and at $I_C = 1$ mA with $V_{CE} = 5$ V, under the constraint $V_E = 3$ V.

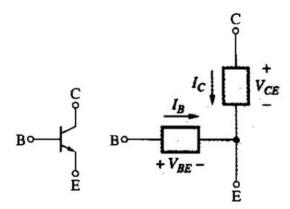


Figure P3.9

primero anotamos los datos que nos entrega el problema

```
clc, clear, close all
format short g

I_B = 10e-6;
V_BE = 0.7;
r1 = V_BE/I_B
```

```
I_C = 1e-3;
V_CE = 5;
r2 = V_CE/I_C
```

```
r2 = 5000
```

0.00101

70000

r1 =

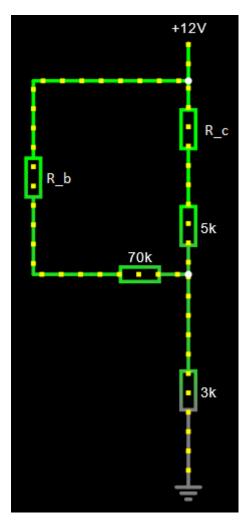
De acuerdo con los datos que nos dan y calculados los valores de resistencia que componen el modelo de BJT. Ahora sabemos por la LCK que la corriente I_E = I_B + I_C, y sabemos el potencial en E, por lo que podemos calcular el valor de resistencia de polarizacion del emisor:

```
I_E = I_B + I_C

I_E =
```

```
V_E = 3;
r_E = V_E/I_E
```

Para saber los valores de r_C y r_B, podemos hacerlo analizando el circuito, para ello, lo visualizamos con sus incognitas y los datos que hasta ahora tenemos:



Vemos que Rc y Rb estan en paralelo, por lo que a amabos les llega 12V inicialmente, asi que tenemos dos rutas de caida de tension.

Sabemos la caida de tension colector-emisor V_CE = 5V, y la caida de tensión en la resistencia de polarización V_E = 3V, entonces por LTK, en el resistor de polarización Rc debe caer una tension de 4V, debido a que es lo que nos falta para que haya una caida de tension de 12V desde la fuente a tierra y asi se respete la LTK. De la misma manera analizamos la ruta de Rb. Lo verificamos calculando:

teniendo las caidas de tension y conociendo las corrientes que pasan, podemos calcular sus valores de resistencia, y lo verificamos en el simulador:

Rb =

830000

$$Rc = V_Rc/I_C$$

Rc =

4000

